



MD 1680 Z 2024.01.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **1680** (13) **Z**
(51) Int.Cl: *C30B 30/02* (2006.01)
C30B 13/08 (2006.01)
C30B 13/22 (2006.01)
C30B 33/04 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENȚIE
DE SCURTĂ DURATĂ

(21) Nr. depozit: s 2022 0050 (22) Data depozit: 2022.07.21	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2023.03.31, BOPI nr. 3/2023
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII "D. Ghițu", MD (72) Inventatori: KONOPKO Leonid, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; PARA Gheorghe, MD (73) Titular: INSTITUȚIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD	

(54) Procedeu de recristalizare a microfirului pe bază de bismut în izolație de sticlă

(57) Rezumat:

Invenția se referă la domeniul materialelor termoelectrice, și anume la procedee de recristalizare a microfiredelor din materiale anizotrope în izolație de sticlă.

Procedeu de recristalizare a microfirului pe bază de bismut în izolație de sticlă constă în mișcarea microfirului printr-un condensator format din două plăci de cupru, care generează un câmp electric puternic,

încălzirea microfirului cu un fascicul laser până la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone de topire înguste, care în direcția de mișcare a microfirului în interiorul condensatorului este imediat recristalizată de un flux de aer, cu direcția axei cristalografice C_3 a microfirului în direcția câmpului electric.

Revendicări: 1

Figuri: 1

MD 1680 Z 2024.01.31

(54) Process for recrystallization of bismuth-based microwire in glass insulation

(57) Abstract:

1
The invention relates to the field of thermoelectric materials, namely to processes for recrystallization of microwires of anisotropic materials in glass insulation.

The process for recrystallization of bismuth-based microwire in glass insulation consists in moving the microwire inside a capacitor, formed by two copper plates, generating a strong electric field, heating the microwire with a laser beam to the core

2
melting temperature with the formation of a narrow molten zone, which, in the direction of the microwire movement inside the capacitor, is immediately crystallized by air flow, with the direction of the crystallographic axis C_3 of the microwire in the direction of the electric field.

Claims: 1

Fig.: 1

(54) Способ рекристаллизации микропровода на основе висмута в стеклянной изоляции

(57) Реферат:

1
Изобретение относится к области термоэлектрических материалов, а именно к способам рекристаллизации микропроводов из анизотропных материалов в стеклянной изоляции.

Способ рекристаллизации микропровода на основе висмута в стеклянной изоляции состоит в перемещении микропровода внутри конденсатора, образованного двумя медными пластинами, генерирующими сильное электрическое поле, нагреве

2
микропровода лазерным лучом до температуры плавления жилы с образованием узкой расплавленной зоны, которая по ходу движения микропровода внутри конденсатора сразу кристаллизуется воздушным потоком, с направлением кристаллографической оси C_3 микропровода по направлению электрического поля.

П. формулы: 1

Фиг.: 1

Descriere:

5 Invenția se referă la domeniul materialelor termoelectrice, și anume la procedee de recristalizare a microfiredelor din materiale anizotrope în izolație de sticlă.

Este cunoscut un procedeu de creștere a cristalelor dintr-o topitură, folosind agent de cristalizare [1]. În acest procedeu este necesar să se asigure contactul inițial al agentului de cristalizare, adică un cristal orientat special, cu topitura sau zona de topire a cristalului recristalizat.

10 Dezavantajul acestui procedeu constă în necesitatea de a asigura contactul inițial al agentului de cristalizare, adică un cristal special orientat, cu zona de topire a cristalului recristalizat.

Cel mai apropiat de soluția propusă este procedeul de recristalizare a microfiredelor pe bază de bismut în izolație de sticlă, în care microfirul de bismut în mișcare este încălzit de un încălzitor rezistiv până la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone topite, care în direcția mișcării microfiredelor se deplasează în interiorul unui condensator, format din două plăci de cupru, generând un câmp electric puternic, unde se cristalizează cu un cristalizator de apă, cu direcția axei cristalografice C_3 a microfiredelor în direcția câmpului electric [2].

Dezavantajele acestui procedeu sunt prezența în procesul de recristalizare a unei zone lungi a topiturii microfiredelor, ~ 10 mm, precum și utilizarea unui cristalizator de apă. Datorită faptului că densitatea topiturii de Bi și aliajelor de Bi-Sb ($\rho_m = 10,05 \text{ g/cm}^3$) este mai mare decât densitatea lor în stare solidă ($\rho_s = 9,78 \text{ g/cm}^3$) (B.B. Алчагиров, А.Г. Мозговой, Т.М. Шампаров. Плотность расплавленного висмута при высоких температурах. Теплофизика высоких температур, 2004, 42, p. 487-490), regiunea topiturii în microfir se îngustează cu formarea unui spațiu gol. Odată cu trecerea procesului de recristalizare, grosimea îngustării se micșorează, ceea ce duce la o ruptură a miezului. Ca urmare, se poate de obținut nu mai mult de 1 m de microfir recristalizat fără rupturi. De asemenea, prezența unui cristalizator de apă în interiorul condensatorului cu o tensiune înaltă ($8 \cdot 10^3 \text{ V/cm}$) poate duce la descărcări necontrolate între plăcile condensatorului.

Scopul prezentei invenții este de a elabora o nouă tehnologie de recristalizare a unui microfir în izolație de sticlă dintr-un material anizotrop (de exemplu, aliaje de Bi și Bi-Sb), lipsită de dezavantajele de mai sus.

30 Problema tehnică rezolvată de invenție este obținerea unui microfir arbitrar subțire și lung dintr-un material anizotrop, de exemplu Bi și Bi-Sb, în izolație de sticlă cu orientarea dorită a axei C_3 față de axa microfiredelor.

În procedeul propus, încălzitorul rezistiv, care topește miezul microfiredelor în izolație de sticlă și este situat în afara condensatorului de înaltă tensiune, format din două plăci de cupru (care este motivul formării unei zone lungi de topire a miezului), este înlocuit cu un fascicul laser focalizat, care topește miezul microfiredelor în interiorul condensatorului, iar regiunea de topire la deplasarea microfiredelor este imediat cristalizată de un flux de aer.

Procedeul de recristalizare a microfiredelor pe bază de bismut în izolație de sticlă constă în mișcarea microfiredelor printr-un condensator format din două plăci de cupru, care generează un câmp electric puternic, încălzirea microfiredelor cu un fascicul laser până la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone de topire înguste, care în direcția de mișcare a microfiredelor în interiorul condensatorului este imediat recristalizată de un flux de aer, cu direcția axei cristalografice C_3 a microfiredelor în direcția câmpului electric.

Avantajele procedeului propus sunt:

45 - posibilitatea recristalizării unui microfir de Bi și Bi-Sb arbitrar lung în izolația de sticlă;
- posibilitatea de recristalizare a microfiredelor de Bi și Bi-Sb arbitrar subțiri în izolația de sticlă;

- creșterea fiabilității funcționării instalației de recristalizare a microfiredelor atunci când cristalizatorul de apă este înlocuit cu unul de aer.

50 Invenția se explică prin desenul din figură, care reprezintă schema instalației pentru recristalizarea microfiredelor de Bi și Bi-Sb în izolație de sticlă pentru a obține la ieșirea din instalație un microfir cu orientarea axei cristalografice principale C_3 pe direcția câmpului electric: 1- microfir din Bi și Bi-Sb în izolație de sticlă; 2- condensator, format din două plăci de cupru situate la o distanță de 1 cm una față de alta; 3 – fascicul laser focalizat; 4 – laser semiconductor, $\lambda = 450 \text{ nm}$, $P = 2 \text{ W}$; 5 - cristalizator (flux de aer).

Exemplu de realizare a invenției

Pentru obținerea unui microfir 1 cu amplasarea axei cristalografice principale C_3 în direcția câmpului electric E, condensatorului 2, format din două plăci de cupru situate la o distanță de 1 cm una față de alta, i se aplică o tensiune de 8 kV, în timp ce în condensator apare un câmp electric $E = 8$

5 kV/cm. Microfirul de bismut în izolație de sticlă 1 este tras prin dispozitiv cu o viteză de 0,4 m/min cu ajutorul a două discuri rotative acoperite cu cauciuc, în interiorul condensatorului, în zona de acțiune a unui câmp electric puternic, miezul microfirului 1 este topit de un fascicul focalizat 3 al unui laser 4 și imediat când microfirul este deplasat, acesta se cristalizează cu un flux de aer 5, în timp ce axa cristalografică principală C_3 în monocristalul solidificat este situată în direcția câmpului electric.

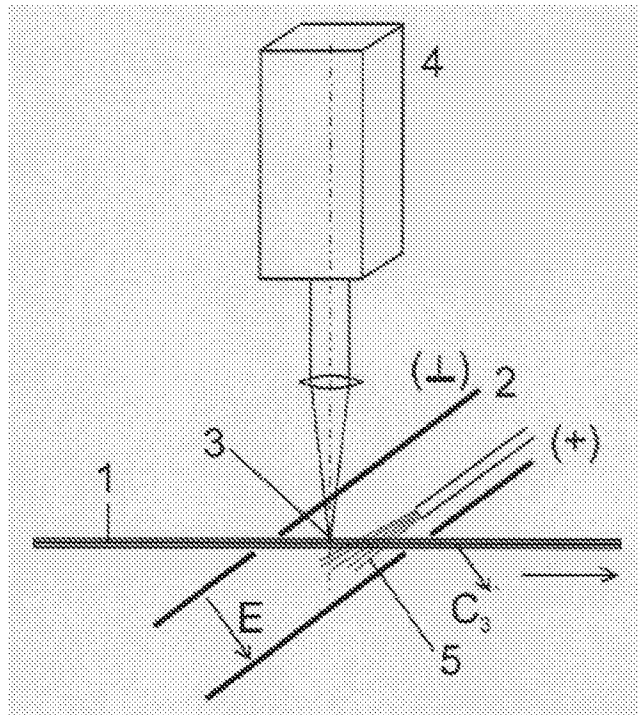
La utilizarea unui laser semiconductor ($\lambda=450$ nm, $P=2$ W) a fost posibilă obținerea unui microfir recristalizat de Bi-0,05% Sn ($D = 18$ μm , $d = 4$ μm) cu lungimea de 9,9 m, din care a fost confecționat un senzor de flux de căldură. Valabilitatea procedurii propusă este garantată de sensibilitatea ridicată (10^{-2} V/W) a senzorului de flux de căldură obținut.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. Пфанн В. Зонная плавка. Мир, Москва, 1970, p. 246-251
2. MD 1409 Y 2019.12.31

(57) Revendicări:

Procedeu de recristalizare a microfirului pe bază de bismut în izolație de sticlă, care constă în mișcarea microfirului printr-un condensator format din două plăci de cupru, care generează un câmp electric puternic, încălzirea microfirului cu un fascicul laser până la temperatura de topire a miezului cu formarea unei zone de topire înguste, care în direcția de mișcare a microfirului în interiorul condensatorului este imediat recristalizată de un flux de aer, cu direcția axei cristalografice C_3 a microfirului în direcția câmpului electric.



RAPORT DE DOCUMENTARE

I. Datele de identificare a cererii

(21) Nr. depozit: s 2022 0050

(22) Data depozit: 2022.07.21

(71) Solicitant: **INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ȘI NANOTEHNOLOGII "D. Ghițu", MD**

(54) **Titlu: Metodă de creștere orientată a monocristalelor în microfirul din material anizotrop (de exemplu Bi și aliajele Bi-Sb) acoperit cu înveliș de sticlă în câmp electric puternic**

II. Clasificarea obiectului invenției:

(51) **Int.Cl:** *C30B 30/02* (2006.01)
C30B 13/08 (2006.01)
C30B 13/22 (2006.01)
C30B 33/04 (2006.01)

III. Colecții și Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuații de căutare reprezentative)

MD - Intern « Documentare Invenții » (inclusiv cereri nepublicate; trunchiere automată stânga/dreapta):

C30B 30/02, C30B 13/08, C30B 13/22, C30B 33/04
 recristalizare, bismut, microfir, condensator, aer

EA (Eapatis):

C30B30/02, C30B13/08, C30B13/22, C30B33/04
 рекристаллизация, перекристаллизация, висмут, микропровод, конденсатор, воздух

IV. Baze de date și colecții de literatură nonbrevet cercetate

www.google.com

V. Documente considerate a fi relevante

Categoria*	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Numărul revendicării vizate
A, D	Пфанн В. Зонная плавка. Мир, Москва, 1970, p. 246-251	1
A, D, C	MD 1409 Y 2019.12.31	1
A	MD 575 Y 2012.12.31	1
A	MD 3662 B1 2008.07.31	1

*** categoriile speciale ale documentelor citate:**

A – document care definește stadiul anterior general	T – document publicat după data depozitului sau a priorității invocate, care nu aparține stadiului pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria pe care se bazează invenția
X – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicând activitate inventivă când documentul este luat în considerație de unul singur	E – document anterior dar publicat la data depozit național reglementar sau după aceasta dată
Y – document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie	D – document menționat în descrierea cererii de brevet
O - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expoziție sau la orice alte mijloace de divulgare	C – document considerat ca cea mai apropiată soluție
	& – document, care face parte din aceeași familie de brevete
P - document publicat înainte de data de depozit, dar după data priorității invocate	L – document citat cu alte scopuri
Data finalizării documentării, 12.12.2022	
Examinatoare , GUȘAN Ala	